(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平4-245129

(43)公開日 平成4年(1992)9月1日

技術表示箇所

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

H01H 85/06

7250-5G

85/08

7250-5G

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

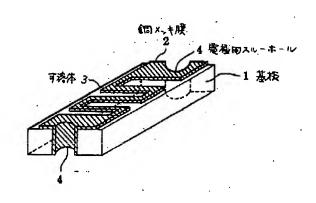
(21)出願番号	特願平3-10063	(71)出願人	000004455
			日立化成工業株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)1月30日		東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
		(72)発明者	三森 誠司
			茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
			成工業株式会社茨城研究所内
		(72)発明者	上原 秀秋
			茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
			成工業株式会社茨城研究所内
		(72)発明者	中田 孝夫
			茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化
			成工業株式会社茨城研究所内
		(74)代理人	弁理士 若林 邦彦
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 チップ型ヒユーズ

(57)【要約】

【目的】 速断性、抵抗の安定性及び量産性に優れたチ ップ型ヒューズを提供する。

【構成】 基板1に、表面粗さが3μmRmax以下の 化学切削性感光性ガラスを用いたチップ型ヒューズ。



1

【特許請求の範囲】

基板に表面粗さが3μmRmax以下の 【請求項1】 化学切削性感光性ガラスを用いたチップ型ヒューズ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子機器等に使用される チップ型ヒューズに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電子機器の誤動作、短絡等の故障 故を防止するために、ガラス管の端子間に金属の可溶材 料を接続した管ヒューズが用いられる。しかし、電子機 器が小型化するにつれ、前記管ヒューズでは大き過ぎ る、量産性に劣る、配線板に表面実装しにくい、などの 問題が生じた。これを解決するために小型化が容易で量 産性に優れ、配線板に表面実装しやすいチップ型のヒュ ーズが提案された。これらのチップ型ヒューズの基板 は、ヒューズが切断されるときに発生する熱を考慮して セラミックが用いられる。通常、セラミック基板として 使用されるアルミナを基板にして量産性に優れたメッキ 20 法で電極や可溶体を形成する方法がコスト面と性能の点 で最も有利である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、アルミナ基板 にメッキ法で電極や可溶体を形成しようとするとアルミ ナ基板を粗化してからメッキする必要があり、可溶体を 形成する部分の表面粗さが5μmRmax以上にもな り、溶融した後の可溶体がその場に残り、速断性が低下 する。また、表面粗さが大きいと可溶体の幅や厚みが一 定にならず、ヒューズの抵抗値が一定しない等の欠点が 30 生じる。

【0004】本発明はメッキ法を用いて作製したチップ 型ヒューズのこのような欠点を改良し、可溶体が溶融し た後の遮断性、特性の均一性及び量産性に優れたチップ 型ヒューズを提供するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、基板に表面粗 さが3μmRmax以下の化学切削性感光性ガラスを用 いたチップ型ヒューズに関する。

板(以下、感光性ガラスと呼ぶ)は、露光によって化学 切削性を有するようになるものであればよく特に制限は ないが、一般に紫外線露光後の熱処理によって露光部分 に弗化水素酸(HF酸)に易溶なメタ珪酸リチウムの結 晶を析出し、この結晶をHF酸で溶解除去後再度熱処理 することによりジ珪酸リチウム結晶を生ずるものが好ま しい。このジ珪酸リチウム結晶を生じた感光性ガラス が、チップ型ヒューズ用基板であり、この基板をHF酸 等に浸潤して表面を粗化した後、公知のめっき、フォト

び可溶体の金属膜を配設し、分割してチップ型ヒューズ とされる。

【0007】粗化後の表面粗さは、3μmRmax以下 である必要があり、これより大きいとメッキ次いでパタ ーンエッチングして形成される可溶体部分の厚さ及び幅 の精度が低下し、ヒューズとしての抵抗値が一定しなく なる。また、3μmRmaxより大きいと、溶融した後 の可溶体が移動し難くなり、速断性が低下する。

【0008】粗化液としては、HF酸と塩酸、硫酸、硝 により生じた過電流による電子機器の発熱、火災等の事 10 酸等の強酸との混酸、HF酸とKF、NaF、LiF等 のアルカリ金属の弗化物との混合液等を用いるのが好ま しく、これらの粗化液を用いれば、粗化後の表面粗さを 3 μmRmax以下にすることができる。

[0009]

【実施例】0. 75mm厚で60mm×60mmの化学 切削性感光性ガラス(住田光学ガラス製、PSG-1) に、スルーホール形成部分に対応するところだけCr蒸 着のない石英ガラスマスクを重ねて、オーク製作所製ガ ラス基板用高精度露光装置ORCHMW-661B-1 を用いて紫外線10J/cm² 照射した。次に、該紫外 線露光したガラスを電気炉に入れ、大気中545℃で3 時間保持して露光部分だけを結晶化させてメタ珪酸リチ ウムを析出させた。該部分的に結晶化させた感光性ガラ スを2NのHF水溶液に90分浸漬し、撹拌して結晶部 分を溶解した。その後、洗浄、乾燥して再度熱処理用の 電気炉に入れ、810℃で2時間熱処理してスルーホー ルを有するチップ型ヒューズ用基板を得た。次にこの基 板を30℃の4NのHFと4Nの塩酸の混酸に液を撹拌 しながら10分間浸漬し、表面を粗化した。

【0010】また、比較例1として、ガラスの粗化に通 常用いられるノングレア液の30℃に保った液に、該熱 処理した基板を液を撹拌しながら10分間浸漬し、同様 に表面を粗化した。

【0011】これらを流水洗浄後30重量%のHC1溶 液に一分間浸渍し、増感剤(日立化成工業製、HS-1 01B) に5分間浸漬後流水洗浄した。次にこれらを密 着促進剤(日立化成工業製、ADP-201)に5分間 浸漬し浸漬後流水洗浄してから、70℃に加熱した無電 解メッキ浴(日立化成工業製、L-59)に2時間浸漬 【0006】本発明において、化学切削性感光性ガラス 40 し、4μmの銅メッキを施した。この後、感光性レジス ト(日立化成工業製、PHT-862AF-40)を銅 メッキ膜上に密着し、可溶体パターン及び電極パターン に対応する部分露光用マスクを該銅メッキ膜を形成した 感光性ガラスに重ね、100mJ/cm2の紫外線を照 射し、1 重量%の炭酸ナトリウム水溶液でレジストを現 像し、塩化銅水溶液で銅メッキ膜をエッチングしてレジ ストフィルムを剥離してから分割して図1に示すチップ 型ヒューズを得た。図において1は感光性ガラスの基 板、2は銅メッキ膜、3は可溶体及び4は電極用スルー リソグラフィ、エッチング等をして基板の表面に電極及 50 ホールである。得られたチップ型ヒューズの可溶体部分 (3)

3

の幅は 60μ m、高さは 4μ m及び長さは1.8mmで

【0012】比較例2としてアルミナ基板を用いたチップ型ヒューズを以下のようにして作製した。

【0013】直径0.8mmのスルーホールを開孔した0.635mm厚で60mm×60mmの96%アルミナ基板を、日立化成工業製脱脂液HCR-201で洗浄し、水洗、乾燥後、350℃に加熱したNaOH融液中に5分間浸液して粗化した。次いで濃度10重量%のH2SO4溶液中に5分間浸液した後水洗してアルミナ表面10を中和した。この後実施例と同様の条件で銅メッキ、フォトマスク形成、エッチングを行った後、分割して図1と同じ構成のアルミナ基板を用いたチップ型ヒューズを得た。得られたチップ型ヒューズの可溶体部分の幅は60μm、高さは4μm及び長さは1.8mmである。

【0014】得られた実施例のチップ型ヒューズ及び比較例のチップ型ヒューズの基板面の表面粗さ及び可溶体部分の抵抗値及び抵抗値ばらつき、2アンペアの電流を流したときの溶断に至るまでの時間の平均値を表1に示した。

【0015】表1から明らかなように、実施例のチップ型ヒューズは比較例のものに比べて基板面の表面粗さが

小さく、可溶体部分の抵抗値のばらつきも小さく、また 2アンペアの電流を流したときの速断性にも優れること が分かった。

[0016]

【表1】

	基板変面組さ	可特件部抵抗值	推新時間
	(µm.Rmax)	(a)	(砂)
宴施例 1	2.3	2 ± 0 . 1	0.001
比較例1	7.5	2 ± 0 . 2	0.01
比較何 2	6.5	2 ± 0 . 2	0.01

[0017]

【発明の効果】本発明のチップ型ヒューズは、抵抗値が 安定し、速断性及び製造の際の量産性に優れる。

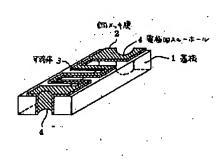
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例におけるチップ型ヒューズである。

【符号の説明】

- 1 基板
- 20 2 銅メッキ膜
 - 3 可溶体
 - 4 電極用スルーホール

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 堀部 芳幸

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内 (72)発明者 池田 正義

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成 工業株式会社下館第二工場内

(72)発明者 廣山 幸久

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成 エレクトロニクス株式会社内